代號:22130 頁次:2-1

109年公務人員高等考試一級暨二級考試試題

等 别:高考二級 類 科:電子工程

科 目:高等電子電路學(包括類比與數位)

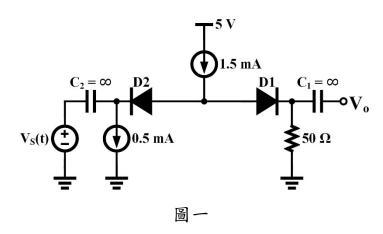
考試時間: 2小時 座號:

※注意:(一)可以使用電子計算器。

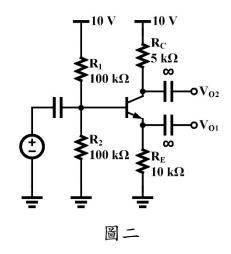
(二)不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外,應使用本國文字作答。

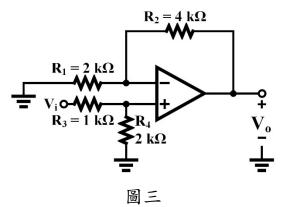
- 一、如圖一電路,二極體電流 I_D 與跨壓 V_D 之關係為 $I_D = I_S e^{V_D/V_T}$,其中之熱電壓 V_T 為 25~mV 。
 - (→)求二極體 D1之偏壓電流 I_{D1}。(10分)
 - 二求小訊號電壓增益 Vo/Vs。(10分)



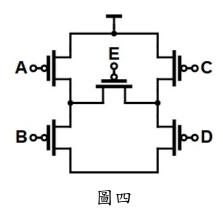
- 二、如圖二電路,由 BJT 構成之放大器電路,其中 BJT 之電流增益 β =100, $|V_{BE}|$ 之壓降為 $0.7\,V$,試回答:
 - (一)此 BJT 操作於主動區 (Active Mode) 或飽和區 (Saturation Mode) ? (10分)
 - 二集極偏壓電流 Ic 值為多少? (10分)



- 三、如圖三所示之運算放大器具無限大之輸入阻抗。
 - (-)如運算放大器之差動增益為無限大,試求 V_o/V_i 值為何? (10分)
 - (三)如運算放大器之差動增益為 $100\,V/V$,試求 V_o/V_i 值為何?(10分)



- 四、使用 CMOS 邏輯電路設計,其 NMOS 區塊與 PMOS 區塊具對偶性 (duality)。
 - (一)若已知 PMOS 區塊如圖四所示,請畫出其 NMOS 區塊。(10分)
 - (二)請繪出邏輯布林函數F=AB+CD之完整 CMOS 邏輯電路。(10分)



- 五、如圖五所示為 MOSFET 與電阻所構成之放大器,假設所有 MOSFET 之小 訊號參數 $g_m=2.0\,mA/V$, $r_o=100\,k\Omega$,且電路中之電阻 $R=50\,k\Omega$,試求:
 - (→)輸出阻抗 R_o。(10分)
 - 二)小訊號電壓增益 V_o / V_i。(10分)

